法政大学学術機関リポジトリ

HOSEI UNIVERSITY REPOSITORY

PDF issue: 2025-07-10

トモシンセシス法を用いた非破壊検査法に関 する研究

KAJITA, Masayuki / 梶田, 雅之

(出版者 / Publisher) 法政大学大学院理工学・工学研究科

(雑誌名 / Journal or Publication Title)

法政大学大学院紀要.理工学・工学研究科編 / 法政大学大学院紀要.理工学・工 学研究科編

(巻 / Volume)
55
(開始ページ / Start Page)
1
(終了ページ / End Page)
6
(発行年 / Year)
2014-03-24
(URL)
https://doi.org/10.15002/00010469

トモシンセシス法を用いた非破壊検査法に関する研究

Research on the non-destructive test method using the Tomosynthesis method

梶田雅之

Masayuki KAJITA 指導教員 尾川浩一

法政大学大学院工学研究科情報電子工学専攻修士課程

The purpose of this paper is to develop a noninvasive inspection of a printed circuit board (PCB). The conventional method uses an x-ray image of the PCB, however the accuracy of inspection is not enough due to the overlapped structure such as a heat sink. The proposed method uses a tomosynthesis method. In this paper the accuracy of imaging was evaluated using simulations in term of the number of projection data, projection orbit and the tilting angle of the projection axis.

1. はじめに

基板検査では、かつて基板は両面基板で、IC の端子は 基板の表面に必ず出ていたため、プローブと言われる測 定器を使うことで回路上の信号を測定することができた. しかし、基板作りの技術が発展し、高度化し、部品も小型 化が進んだ.その結果、基板にプローブを使って測定をす ることができなくなった.このため、非接触で測定・検査 ができる技術が必要とされるようになった.

非接触で検査を行う方法として, IC の端子内に電子的 なテストプローブを内蔵し, IC の中にプローブに相当す る回路をあらかじめ仕込み, IC の中のテスト回路とワー クステーションをシリアル通信で結んで操作するという ものがある.[2]この方法は複雑な基板でも検査できるが, 基板全体の検査が不可能ということと基板内に組み込ま れているので、テストパターンを変えて行うことが面倒 という欠点がある.また,進化した基板では,実装後にそ の導通を確認したいとなると、非常に難しく、部品が正し く半田づけされているかどうかを検査することができな い.そこで,X線を使って,部品実装後に中まで半田付け がされているかという検査がよく行われるようになった. 実際には,X線を傾斜させ,撮影位置を変えることによっ て基板の上下面の情報をずらして検出器に写す.そのず れの量によって、上下面の情報を見ることができる.この 手法では,上下面の情報を正確に見ることができるが,基 板内の全ての層を確実に見ることができないことと,と ても高価であるという欠点を持っている.

その他の方法は, 基板の内部を見ることができる手法 はなく, 内部を見るためには破壊するしかない.

そこで,我々は X 線を用いるトモシンセシス法という

方法を基板検査に応用することにした.

2. トモシンセシス法の原理

トモシンセシス法は、多方向から X 線を照射し、投影画 像を作成し、その画像を画像処理によって再構成するこ とである層だけ強調された画像を作成することができる 手法である.

トモシンセシス法の原理は,まず多方向から X 線を照 射する.投影画像の結果はそれぞれの層がずれて投影さ れる.そして,投影画像のずれを利用してその画像を注目 する層にシフトして加算を行う.その結果,注目している 層以外はぼけて,注目する層は強調してみることができ る.[1]

3. シミュレーション方法と結果

シミュレーションの物体は 100 スライスあり,50 スラ イス目に図1のような複数の円を置いた画像とそれ以外 のスライスには四角形を置いた.もう一つは 50 スライス 目に図3のような複数の四角形を置いた画像とそれ以外 のスライスには四角形を置いた.図1のrは半径(pixel),v は濃度値を示す.図3のtは一辺の長さ(pixel)を示し,濃度 値vは図1と同じである.図2と図4に図1と図3のプロ ファイルを示す.プロファイルは図1と図3の矢印のと ころでとった.また,図5と図6に物体を真上から見た図 を示す.



図1 円を置いた物体の原画像(50 スライス目)





図3四角形を置いた物体の原画像(50スライス目)



図4 図3のプロファイル

•							
•	•						
			•				
*							
•	•						
•							
ľ							
*							
i S	•						
•							
			K	k			
* •							
*		•	٠	•			
* *							
*							
*							
*							

図5物体を真上からみた画像

			ł	H							

図6物体を真上からみた画像

(1) 投影数の比較

トモシンセシス法において,円方向からX線を照射し, 投影数を変化させて画質の比較を行った.ここでは,投影 数を8,16,32,64,128投影に変化させてそれぞれ行った.

また,補間方法として線形補間を使った.

今回のジオメトリを図7に示す.

評価方法として,画像のプロファイルからコントラス ト分解能を計算した.コントラスト分解能の式はプロフ ァイルの最高値をプロファイルの最高値と最低値を足し た値で割った値とした.コントラスト分解能は原画像の 値が1なので,1に近いほど良い数値であるとする.

シミュレーション結果としてそれぞれの物体を投影し, シフト加算後のコントラスト分解能の値のグラフを図 8 と図9に示す.



図7円方向から投影を行うジオメトリ





図9四角を置いた画像をシフト加算したときの評価

(2)角度の比較

トモシンセシス法において、円方向からX線を照射し, 角度を変化させて画質の比較を行った.角度は第3章で行 った13.5度と45度を行った.物体・ジオメトリ・補間方 法・評価は第3章と同じである.

シミュレーション結果としてそれぞれの物体を投影し, シフト加算後のコントラスト分解能の値のグラフを図 10 と図 11 に示す.







図11 四角を置いた画像をシフト加算したときの評価

(3) 投影方向の比較

トモシンセシス法において,円方向と四角方向から X 線を照射し,投影方向を変化させて画質の比較を行った. 円方向については物体・ジオメトリ・補間方法・評価は 第3章と同じである.また,四角方向については物体・補間 方法・評価は第3章と同じである図12に四角方向からの 投影のジオメトリの図を示す.

シミュレーション結果としてそれぞれの物体を投影し, シフト加算後のコントラスト分解能の値のグラフを図 13 と図 14 に示す.



図 12 四角方向のジオメトリ





図 13 円を置いた画像をシフト加算したときの評価



4. 基板を想定したシミュレーション

(1)シミュレーション内容

3-(2)と物体以外は同じ条件で評価をおこなった.なお, 角度は 45 度だけで行った.物体は基板をイメージして, はんだづけのところを見ることを目的とした.

(2)シミュレーション条件

図15に物体を真上からみた画像と図16と図17に半田 を想定して置いた10スライスと31スライスの画像を示 す.また四角形は基板銅を,図16と図17以外の円は放熱 フィンを想定している.



図 15 真上からみた図



図 16 物体の 10 スライス目



図 17 物体の 31 スライス目

(3) シミュレーション結果

投影し,10スライスと31スライスにシフト加算後の画 像を図18と図19に示す.



図 18 10 スライス目



図 19 31 スライス目

5. 実際の基板に対しての実験

(1)シミュレーション内容

実際の基板に対して有効であるか確かめるために,ト モシンセシスをした.

(2) シミュレーション条件

図 20 に基板の画像と図 21~23 にその基板を 0 度,90 度,180 度から投影した画像を示す.



図 20 基板の画像



図21 0度から投影した画像



図 22 90 度から投影した画像



図 23 180 度から投影した画像

(3) シミュレーション結果

図 24~26 に半田の見えやすい位置にシフトして加算 した画像を示す.



図 24 基板の 41 スライス目



図 25 基板の 42 スライス目



図 26 基板の 43 スライス目

6. まとめ

投影数をあげた場合, グラフから, 投影数をあげること によって, 見たい層にシフトしたときにより周りの画像 をぼかし見たい層の画像を強調できた.

円と四角を置いた物体の結果画像の比較から注目する 層の物体の領域が小さいほどばかすことができた.

グラフからも,角度をあげることによってより強調さ れた画像を作成することができた.それは,角度をつける ことによってそれぞれの層がずれて,注目する画素以外 の画素をぼかすことができたからだと考えられる.

投影方向の比較に関してはコントラスト分解能の値か らわずかながら四角方向の方がよい結果が得られた.四 角方向は円方向の円にほぼ外接している四角形なので円 方向より,角度がついたので良い結果になったと考えら れる.

基板を想定した画像で投影を行って、シフト加算後の 画像ははんだを想定している層以外はぼやけて、はんだ が強調されている.また、はんだを想定している画像の中 に画素値が低い円をいれたがその円も完全に強調されて みることができた.

実際の基板に対してもトモシンセシスが有効だと考え られる.それは,投影画像は黒い丸ではんだが見えなくな っているが,半田の位置にシフトして加算を行った画像 では黒い丸がぼやけてはんだが見えるようになっている. しかし,完全に層が分離して見えてはいないので,まだよ い結果ではない.

今後の課題としては、今はまだ重なりがあるので、実際の基板に対してもっと実験を行い重なりをなくすことである.シミュレーションの結果より、角度をつけることによって、よい画像ができると考えられる.

参考文献

- 1) 篠原 広行: "断層映像法の基礎 トモシンセシス(ラ ミノグラフィ)",pp15-(1)-18-(4),2012
- 2) Colin M. Maunder and Rodham E. Tulloss:"THE TEST ACCESS PORT AND BOUNDARY-SCAN ARCHITE",pp1-27,2001